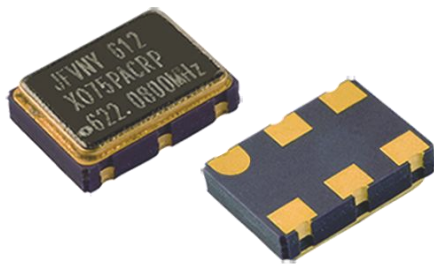


XO75P/ XO75L/ XO75H



产品特点及应用范围:

- LVPECL、LVDS、HCSL 输出
- 体积小
- 盘带包装
- 无铅环保产品
- 可靠性高
- SDH
- 高速信号处理
- 万兆接入设备
- PCIE 总线



产品性能

性能参数		条件	XO75P	XO75L	XO75H
频率范围 (MHz)	F ₀		10.000~800.000		13.50~200.0
标称频率 (MHz)	F ₀		106.25, 125, 155.52, 156.25		
频率准确度	F _{tol}	AT 25°C	≤±25 ppm		
工作温度范围	T _{OPR}		见下表		
工作电压	V _{DD}		A:+3.3VDC±5%; D:+2.5VDC±5%		
工作电流	I _{DD}	10M≤F ₀ <80M	60mA Max.	50mA Max.	30mA Max.
		80M≤F ₀ <160M	75mA Max.	60mA Max.	40mA Max.
		160M≤F ₀ ≤800M	100mA Max.	80mA Max.	50mA Max.
输出波形	Output Wave		P: LVPECL	L: LVDS	H: HCSL
输出负载	Output Load		50Ω	100Ω	50Ω
待机电流	Stand-by Consumption		30μA Max		
抖动	RMS Jitter	12KHz~20MHz	1pS typ. (3pS Max.)		
输出对称性	SYM	50% Waveform	40%~60%		
上升/下降时间	Tr/Tf	20%~80%	1 ns Max.	0.8 ns Max.	0.8 ns Max.
输出电平	"0"电平	V _{OL}	(V _{DD} -1.620)VM	0.9V Min.	0.15V Max.
	"1"电平	V _{OH}	(V _{DD} -1.025)VMi	1.6V Max.	0.44V Min.
启动时间	T _s		10mS Max.		
老化率	F _{age}	25°C±3°C	±5×10 ⁻⁶ /年 Max.		
储存温度范围	T _{stg}		-55°C~+125°C		

频率温度稳定度选型表

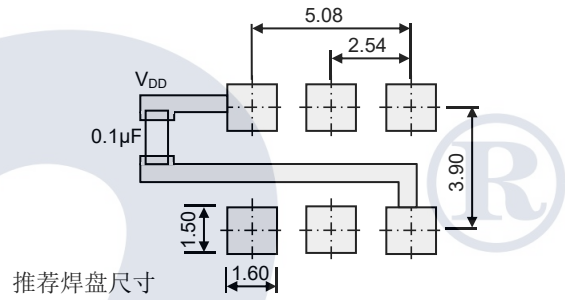
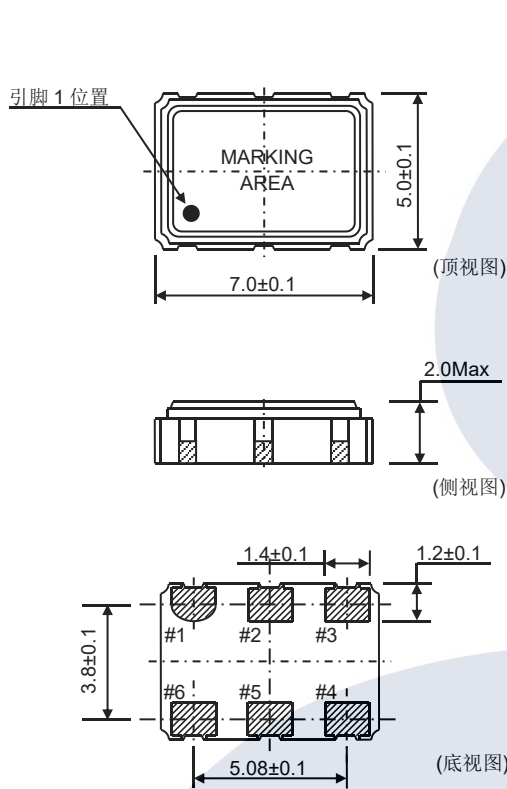
工作温度范围	频率稳定度			
	Q:±20×10 ⁻⁶	R:±25×10 ⁻⁶	T:±50×10 ⁻⁶	U:±100×10 ⁻⁶
C:-20°C ~ +70°C	●	●	●	●
Δ G:-40°C ~ +85°C		●	●	●
∇ Q:-40°C~+125°C			●	●
☆ H:-55°C ~ +85°C			◎	◎
☆ J:-55°C~+125°C			◎	◎

●: 可选产品 ◎: 定制产品 Δ: 工业级 ∇: 汽车级 ☆: 军品级

注: 频率温度稳定度选型表中未标注的需与我方沟通确认

XO75P/ XO75L/ XO75H

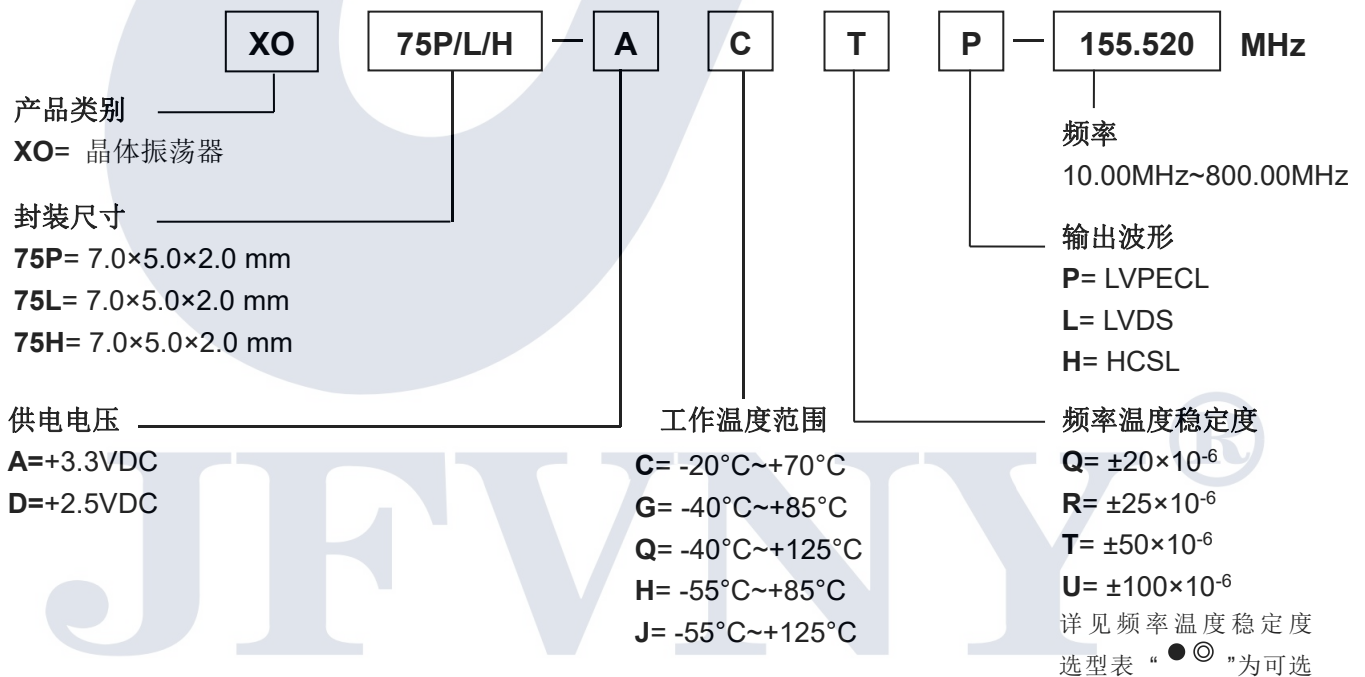
外形尺寸 (mm)



引脚	功能	引脚	功能
#1	三态端	#4	正向输出
#2	悬空	#5	反向输出
#3	接地	#6	电源

三态功能说明	
#1	#4、#5
高电平 (70%V _{DD} Min.) 或开路	有输出
低电平 (30%V _{DD} Max.) 或接地	无输出

选型指南



选型范例

- XO75P-ACTP-155.520MHz 晶体振荡器 / +3.3VDC / -20°C~+70°C / ±50×10⁻⁶ / LVPECL / 155.520MHz
- XO75L-ACTL-155.520MHz 晶体振荡器 / +3.3VDC / -20°C~+70°C / ±50×10⁻⁶ / LVDS / 155.520MHz
- XO75H-ACTH-155.520MHz 晶体振荡器 / +3.3VDC / -20°C~+70°C / ±50×10⁻⁶ / HCSL / 155.520MHz